



Транзисторы кремниевые меза-эпитаксиально-планарные структуры *p-n-p* усилительные. Предназначены для применения в усилителях, преобразователях и импульсных устройствах. Корпус пластмассовый с жесткими выводами.

Масса транзистора не более 2,5 г.

Электрические параметры

| | |
|---|---------|
| Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ: | |
| при $U_{кэ}=1$ В, $I_{к}=1$ А для КТ835А, не менее | 25 |
| при $U_{кэ}=5$ В, $I_{к}=2$ А для КТ835Б | 10 100 |
| Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ, не менее | 1 МГц |
| Напряжение насыщения коллектор — эмиттер, не более: | |
| при $I_{к}=1$ А, $I_{б}=0,2$ А для КТ835А | 0,35 В |
| при $I_{к}=3$ А, $I_{б}=0,6$ А для КТ835Б | 2,5 В |
| Обратный ток коллектора при $U_{кб}=U_{кб, макс}$: | |
| КТ835А | 100 мкА |
| КТ835Б | 150 мкА |
| Емкость коллекторного перехода при $U_{кб}=30$ В, не более | 800 пФ |

Предельные эксплуатационные данные

| | |
|---|------------------------------|
| Постоянное напряжение коллектор — база: | |
| КТ835А | 30 В |
| КТ835Б | 45 В |
| Постоянное напряжение коллектор — эмиттер | 30 В |
| Постоянное напряжение база — эмиттер | 4 В |
| Постоянный ток коллектора: | |
| КТ835А | 3 А |
| КТ835Б | 7,5 А |
| Постоянная рассеиваемая мощность при $T_{к}=-40...+25$ °С | 25 Вт |
| Температура <i>p-n</i> перехода | +125 °С |
| Температура окружающей среды | -40 °С $T_{к}=$ = +100 °С |